

а 2018 0109

Изобретение относится к полупроводниковой технике и может быть использовано, в частности, в устройствах для преобразования солнечного излучения в электрическую энергию.

Способ роста структуры $p^+InP-pInP-n^+CdS$ для фотоэлектрических элементов состоит в том, что выращивают слой p^+InP на подложке, выполненной в виде пластины из p^+InP с кристаллографической ориентацией (100), разориентацией $3...5^\circ$ в направлении (110) и с концентрацией носителей заряда 10^{18} см^{-3} , осаждают, на фронтальную часть пластины, методом квазизамкнутого объема, слой n^+CdS , осаждают на обратную сторону пластины омический контакт из $Ag+5\%Zn$, термически обрабатывают при температуре 450°C , осаждают омический контакт из In на слой n^+CdS , термически обрабатывают при температуре 250°C , и осаждают методом испарения электронным пучком, при температуре 300°C , антиотражающий слой SiO_2 .

П. формулы: 1